

LEYBOLD®

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 16.12.2025

Ref: 578772

Transistor à éffet de champ J112

Transistor à effet de champ pour la réalisation d'expériences de base dans le domaine de l'électronique.

Caractéristiques techniques:

- FET à canal N

- Puissance dissipée : max. 625 mW

- Applications : étages d'entrée à haute impédance

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Electicité/Electronique > Électricité/électronique (STE) > Transistors STE